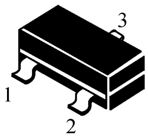
SOT—23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

Excellent H_{FE} Linearity H_{FE} 線性特性極好

：$H_{FE}(0.1mA)/H_{FE}(2mA)=0.95$(Typ.)

Low Noise 低噪声：NF=1dB(Typ.),10db(Max.).

Complementary to S1815

■MAXIMUM RATINGS（T_A=25℃）最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	-50	Vdc
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	-50	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	-5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	Ic	-150	mAdc
Base Current 基極電流	I_B	-30	mAdc
Collector Power Dissipation 集電耗散功率	P_C	225	mW
Junction Temperature 結溫	T_j	150	℃
Storage Temperature 儲存溫度	T_{stg}	-55～150	℃

■DEVICE MARKING 打標

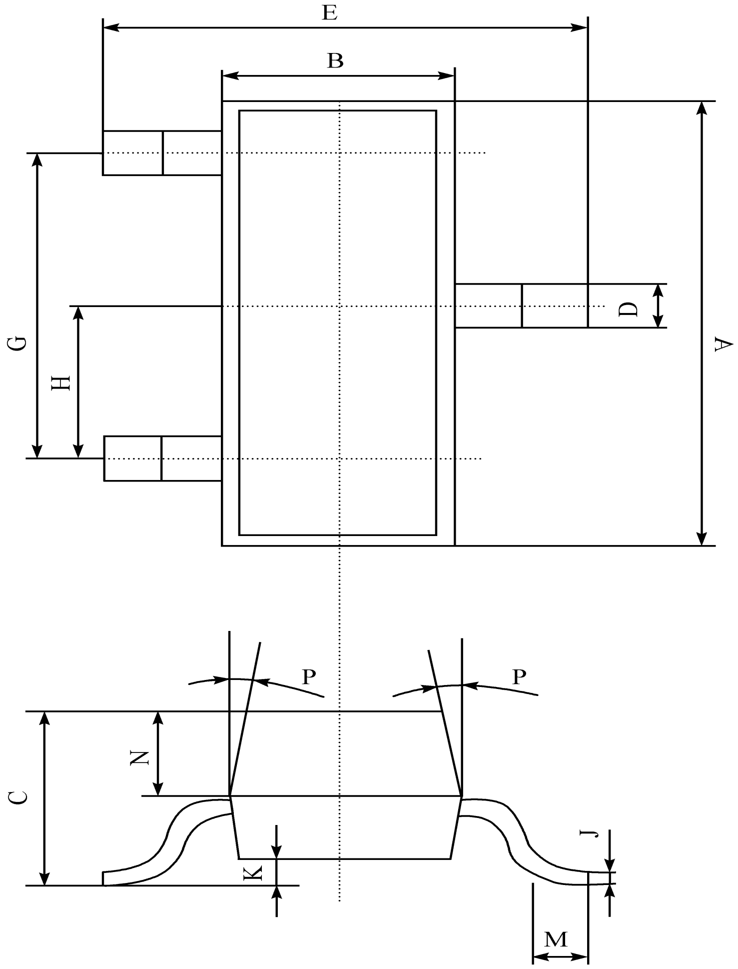
S1015=BA

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(T_A=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度爲 25℃**)**

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	TYP 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	V_{CB}=-50V, I_E=0	—	—	-0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	V_{EB}=-5V, I_C=0	—	—	-0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	I_C=-100μA	-50	—	—	V
Collector Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	I_C=-1.0mA	-50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	I_E=-100μA	-5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	h_{FE}	V_{CE}=-6V, I_C=-2mA	70	—	400	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	I_C=-100mA, I_B=-10mA	—	—	-0.3	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	V_{BE}	V_{CE}=-5.0V, I_C=-10mA	—	—	-0.82	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	V_{CE}=-5.0V, I_C=-10mA	100	180	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	V_{CB}=-10V, I_E=0,f=1MHz	——	4.0	7.0	pF

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	２．９０±０．１０
B	１．３０±０．１０
C	１．００±０．１０
D	０．４０±０．１０
E	２．４０±０．２０
G	１．９０±０．１０
H	０．９５±０．０５
J	０．１３±０．０５
K	０．００－０．１０
M	⩾０．２
N	０．６０±０．１０
P	７±２°